

# 实验十三 半导体激光器模式测量

## 一 实验目的

1. 了解半导体激光器的工作原理和工作特性；
2. 掌握半导体激光器模式参数的测量方法。

## 二 实验原理

### 2.1 半导体激光器的模式特点

半导体激光器的模式分为空间模和纵模。空间模描述围绕输出光束轴线某处的光强分布，或者是空间几何位置上的光强（或光功率）的分布，也称远场分布；纵模则表示一种频谱，它反映所发射的光束其功率在不同频率（或波长）分量上的分布。二者都可能是单模或者多模。边发射半导体激光器具有非圆对称的波导结构，而且在垂直于异质结平面方向（称横向）和平行于结平面方向（称侧向）有不同的波导结构和光场限制情况。横向上通常是异质结构成的折射率波导，而在侧向目前多是折射率波导（但也可采取增益波导），因此半导体激光器的空间模式又有横模与侧模之分[13]。图 13.1给出了这两种空间模式的分布情况。

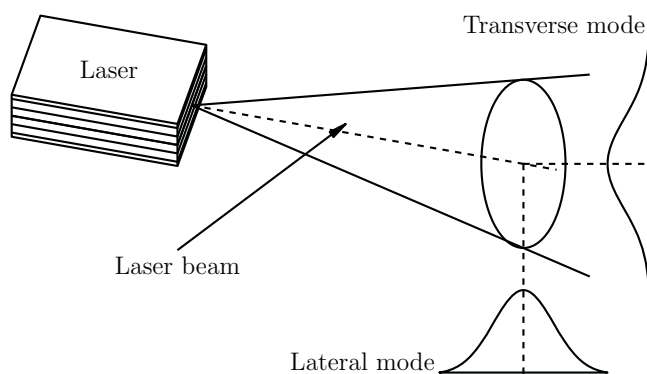


图 13.1: 半导体激光器横模与侧模能量分布示意图。

由于有源层厚度很薄（约为 $0.15\mu\text{m}$ ），因此横向上能保证在单横模工作。但是在侧向，其宽度相对较宽，因而可能出现多侧模。如果在这两个方向都能以单模（或称基模）工作，则为理想的TEM00模，此时出现光强峰值在光束中心且呈“单瓣”结构。这种光束的光束发散角最小、亮度最高，能与光纤有效地耦合，也能通过简单的光学系统聚焦到较小的斑点。。相反，若有源区宽度较宽，则发光面上的光场（称近场）在侧向表现出多光丝，好似一些并行的发光丝，在远场的侧向则有对应的光强分布，如图 13.2所示。这种多侧模的出现以及它的不稳定性，易使激光器的 $P \sim I$ 特性曲线发生“扭折”（kink），使 $P \sim I$ 线性特性变差，这对信号的调制非常不利。同时多侧模也影响与光纤的耦合效率，而且侧模的不稳定性也影响输出功率的稳定性；不能将这种多侧模的激光束聚焦成小的光斑。

由于半导体激光器发光区几何尺寸的非对称特性，其远场一般呈椭圆状。其长、短轴分别对应于横向与侧向。在许多应用中需用光学系统对这种非圆对称的远场光斑进行圆化处理。如果半导体激光器发射的是理想的高斯光束，应有如下的光强分布：

$$I(r) = I_{max} \exp[-2(r/w)^2] \quad (13.1)$$

式中， $I(r)$ 是在束腰半径为 $w$ 的高斯光束内，径向尺寸为 $r$ 处的光强， $I_{max}$ 为束腰内的最大光强。显然，当 $r = w$ 时，该处的光强为 $I_{max}$ 的 $1/e^2$ （即光强峰值的13.5%），如图 13.3所示。高斯光束峰值强度一半处的发散角为

$$\theta = 4\lambda/(\pi w) = 1.27\lambda/w \quad (13.2)$$

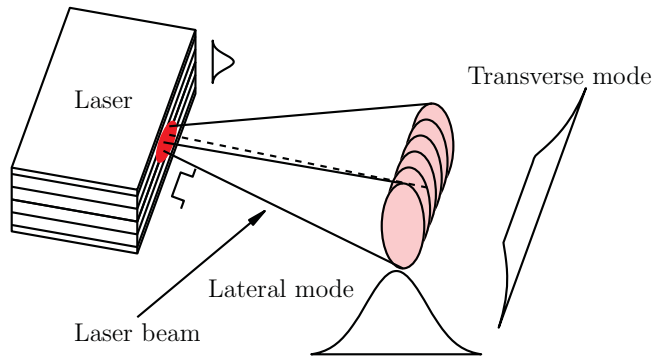


图 13.2: 有多侧模的半导体激光器的近场和远场。

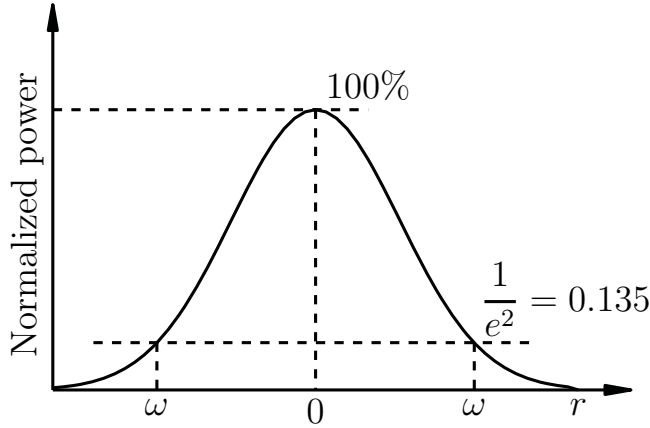


图 13.3: 理想的高斯光束的场强分布。

## 2.2 半导体激光器的光束整形

半导体激光器的远场并非严格的高斯分布，在横向和侧向有较大的不对称光束发散角，由于半导体激光器有源层较薄，因而在横向有较大的发散角 $\theta_a$ ，根据经验公式，可表示为

$$\theta_{\perp} = \frac{4.05(n_2^2 - n_1^2) \cdot d/\lambda}{1 + 4.05(n_2^2 - n_1^2) \cdot (d/\lambda)^2/1.2} \quad (13.3)$$

式中， $n_2$ 和 $d$ 分别为激光器有源层的折射率和厚度； $n_1$ 为限制层的折射率； $\lambda$ 为激光波长。显然，当 $d$ 很小时，可忽略式13.3分母中的第二项，则有

$$\theta_{\perp} \sim 4.05(n_2^2 - n_1^2)d/\lambda \quad (13.4)$$

由方程(13.4)可见， $\theta_{\perp}$ 随 $d$ 的增加而增加，这可解释为随着 $d$ 的减少，光场向两侧有源层扩展，等效于加厚了有源层，而使 $\theta_{\perp}$ 减少。当有源层厚度能与波长相比拟，但仍工作在基横模时，可以忽略方程(13.3)分母中的1，因而可以近似为：

$$\theta_{\perp} \approx 1.2\lambda/d \quad (13.5)$$

方程(13.5)与方程(13.2)的一致性说明，在一定的有源厚度范围内，横向光场具有较好的高斯光束特点。并且在此范围内， $\theta_{\perp}$ 随 $d$ 的增加而减少，可用衍射理论解释。在量子阱半导体激光器中，由于有高的微分增益 $d_g/d_N$ ，允许适当放松对有源层与波导模之间耦合的要求而允许模场的适当扩展，因而具有比厚有源层半导体激光器更小的 $\theta_{\perp}$ 。

可以通过外部光学系统来压缩半导体激光器的发散角，以实现相对准直的光束。但这是要以损耗一定的光功率为代价的。如果将从半导体激光器发出的激光近似视为高斯分布的点光源，可以采取图 13.4所示的准直光学系统。

准直透镜的数值孔径必须大于半导体激光器的有效数值孔径 $(n_2^2 - n_1^2)1/2$ ，此时经准直后的激光束，以及聚焦后的焦斑仍是椭圆。如果需得到小而圆的光点，尚需对准直后的光束进行圆化处理。用自聚焦透镜可方便地对半导体激光器出射光进行准直，如图 13.5所示。

半导体激光器中存在像散（像散是像差的一种）。当用光学系统对半导体激光器的近场成像时，就会发现，由于像散的存在会在焦线上出现两个像点。半导体激光器在横向都是利用有源层两边折射率差所形成的光波导效应，对有源区光子进行限制的，而在侧向则存在增益波导与折射率波导两种限制类型。

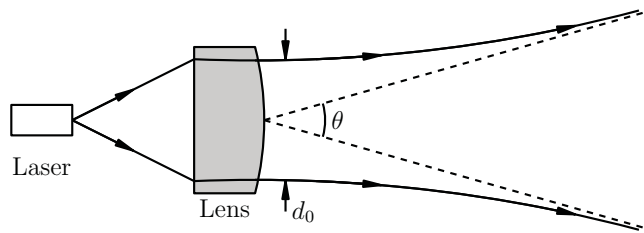


图 13.4: 高斯光束的准直光学系统。

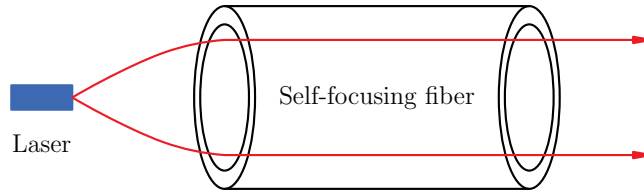


图 13.5: 用自聚焦透镜系统对半导体激光束进行准直。

早期的条形激光器是增益波导型的，有非平面波前。目前大量采用的侧向折射率波导结构，在垂直于结平面的方向，高斯光束的束腰在解理面上，且在束腰处为平面波前，如图 13.6(a)所示。而当侧向的波导结构由复折射率的虚数部分起主要作用时（即增益波导），则从该处发出的光场分布如图 13.6(b)所示，在腔内距腔面为  $D$ （称像散量）的地方出现虚腰，这也是外部观察者所能看到的最小近场宽度，真正的束腰在腔中心。因此，从传播方向看去，两个方向的合成波前呈圆柱面，如图 13.6(c)所示。

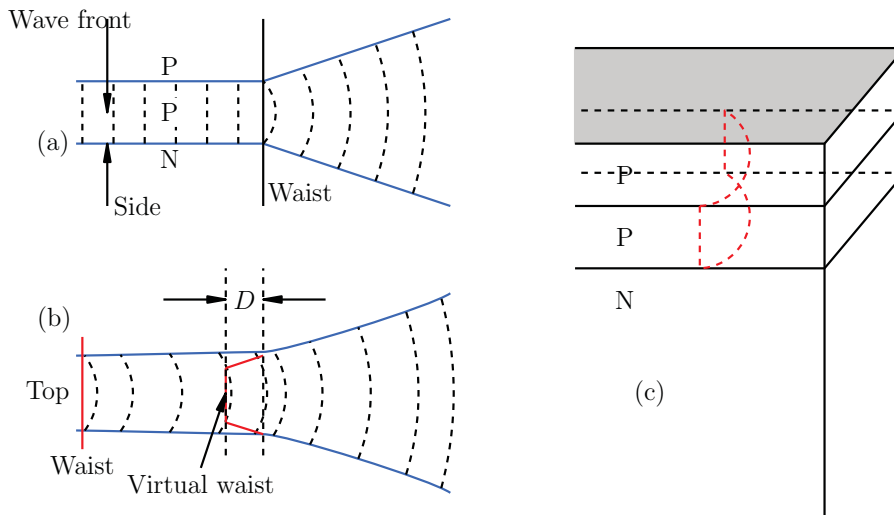


图 13.6: 增益波导激光器波前。(a)垂直于结平面方向；(b)平行于结平面方向；(c)合成波前。

### 2.3 影响半导体激光器模式的因素

半导体激光器的辐射波长是由半导体的禁带宽度  $E_g$  决定的，但是这一波长也必须满足谐振腔内的模式谐振条件。谐振条件决定着激光辐射波长的精细结构。因为不同振荡波长间不存在损耗的差别，而它们的增益差又小，故除了由禁带宽度  $E_g$  所决定的波长能在腔内振荡外，在它周围还有一些满足谐振腔驻波条件的波长也可能在有源介质的增益带宽内获得足够的增益而起振。因而有可能存在一系列振荡波长，每一波长构成一个振荡模式，称之为腔模或纵模，如图 13.7 所示。这些纵模之间的间隔  $\Delta\lambda$  和  $\Delta\nu$  分别为：

$$\Delta\lambda = \lambda^2/2n_gL \quad (13.6)$$

$$\Delta\nu = c/2n_gL \quad (13.7)$$

式中， $\lambda$  为辐射波长； $c$  为光速； $n_g$  为有源材料的群折射率。

一般的半导体激光器其纵模间隔为  $0.5 \sim 1\text{nm}$ ，而激光介质的增益谱宽为数十纳米，因而有可能出现多纵模振荡。然而传输速率高的光纤通信系统，要求半导体激光器是单纵模的。这是为了避免由于光功率在各个纵模之间随机分配所产生的所谓模分配噪声；同时纵模的减少也是得到窄光谱线宽所必须的条

件。而窄的线宽有利于减少在高数据传输速率光纤通信系统中光纤色散的影响。即使有些激光器连续工作时是单纵模的，但在高速调制下由于载流子的瞬态效应，而使主模两旁的边模达到阈值增益而出现多纵模振荡，如图13.7所示。因此必须考虑纵模的控制特性。为了得到单纵模，应弄清纵模的模谱，影响单纵模存在的因素，才能设法得到所要求的单纵模激光器。

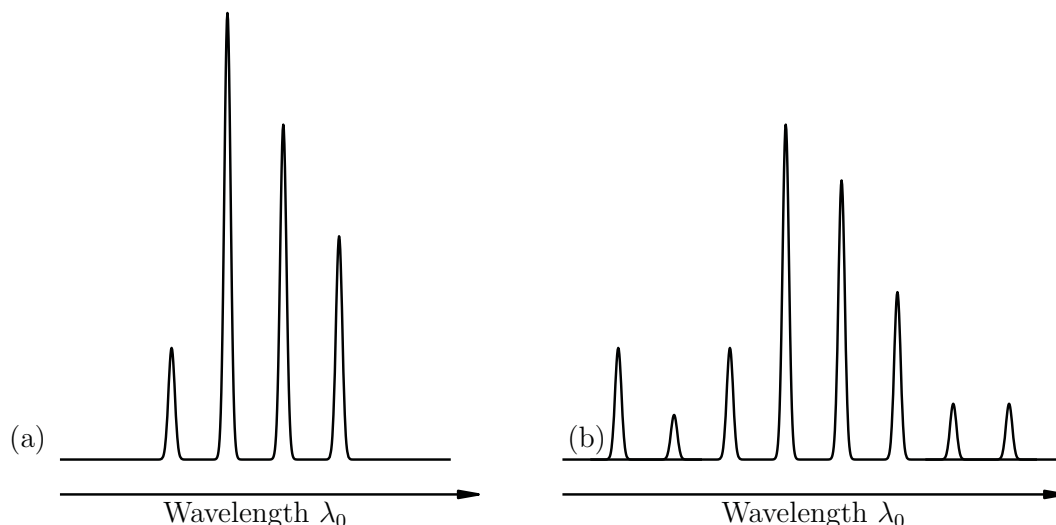


图 13.7: 激光器的纵模谱。(a)只有少数纵模；(b)高速调制下的附加纵模。

半导体激光器的有源区特性和器件结构都对纵模谱产生影响，以下就一些主要影响因素进行分析。

1. 自发辐射因子的影响：自发辐射对半导体激光器的主要影响是：

- (a) 使  $P - I$  特性曲线“变软”；
- (b) 在稳态条件下振荡模的噪声谱和光谱加宽；
- (c) 阈值以上的边模抑制比下降；
- (d) 在直接调制下张弛振荡频率降低。

一般来说，半导体激光器比气体和固体激光器高约5个数量级的自发发射因子 ( $10^{-4}$ )。由图 13.8可以看出，纵模谱随  $\gamma$  变化很大。当  $\gamma = 10^{-5}$  时，几乎所有的激光功率集中在一个纵模内，即单纵模工作；当  $\gamma = 10^{-4}$  时，只有约80%的光功率集中在主模上，而其余的由旁模所分配；当  $\gamma = 10^{-3}$  时，则有更多的纵模参与功率分配。另一方面，若自发发射因子  $\gamma \rightarrow 1$  (如在微腔情况)，此时每一个自发发射光子引发出一个受激发射光子，能得到很好的单纵模。

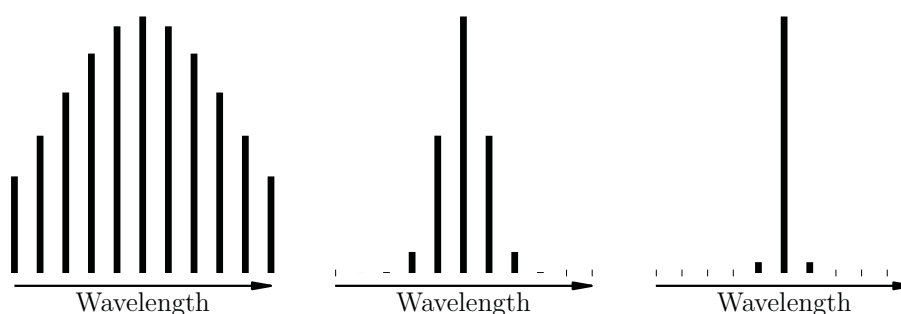


图 13.8: 腔长250 $\mu\text{m}$ ，输出功率2mW的激光器的模谱。(a) $\gamma = 10^{-3}$ ；(b)  $\gamma = 10^{-4}$ ；(c)  $\gamma = 10^{-5}$ 。

- 2. 模谱与电流密度的关系：若激光器具有标准腔长 (250 $\mu\text{m}$ ) 和典型的  $\gamma = 10^{-4}$ ，实验发现，在小于阈值的低注入电流时，模谱的包络与自发发射谱类似；当电流增加到阈值以上，模谱包络变窄，各纵模振荡开始竞争，对应于增益谱中心的主模 ( $q = 0$ ) 增长比邻近纵模快。随电流增加，激光能量向主模转移，而且峰值波长发生红移现象，这种红移量约为0.1nm/mA左右。
- 3. 器件结构对模谱的影响：侧向有折射率波导的激光器比增益波导结构的激光器表现出更好的纵模特性。图13.9表示的是波长为780nm的两种侧向波导结构的纵模谱。该结果表明有源区内载流子限制能力越强，腔内的微分增益越高，不但横模特性得到改善，纵模特性同样向单纵模方向转化。

在一般的法布里—珀洛(FP)谐振腔中，各个纵模分量在腔内得到反馈的量是相同的。在分布反馈(DFB)、分布布拉格反射(DBR)和有外部光栅谐振腔的结构中，谐振腔具有对某一波长选择反馈

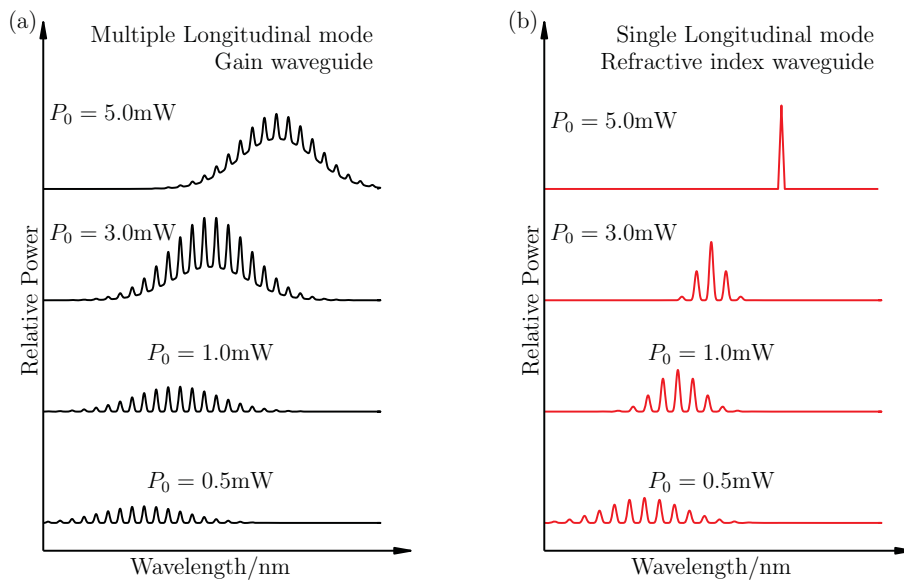


图 13.9: 折射率波导与增益波导纵模谱的比较。

的作用，因而有好的纵模特性。图 13.10 比较的是在 1300nm 波长、侧向折射率波导的 FP 腔和 DFB 腔的纵模特性。若谐振腔很短，则纵模间隔很大。其 3dB 增益带宽内允许振荡的纵模数减少。当主模两边的次模随着腔长的缩短而移出 3dB 增益带宽之外，则可出现单纵模振荡。

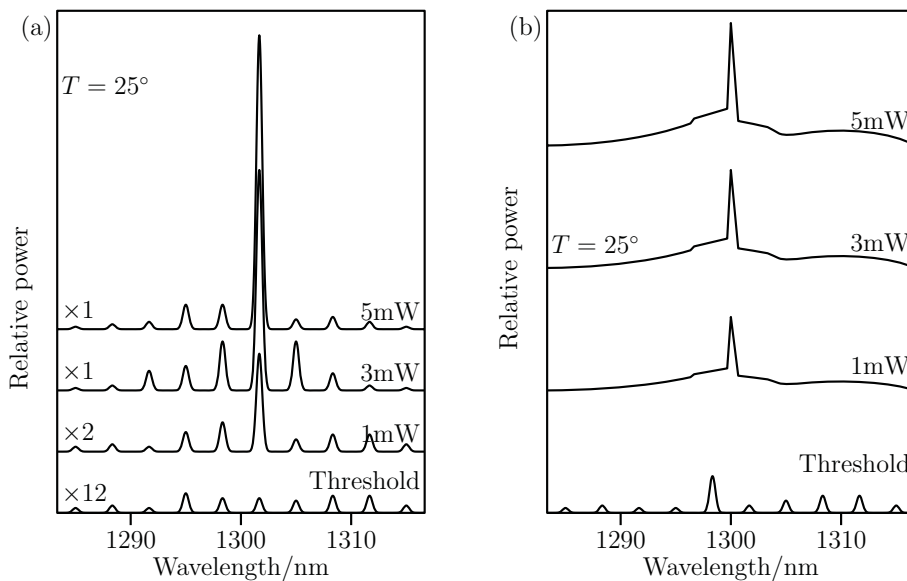


图 13.10: 不同谐振腔结构的纵模谱。(a) FP 腔；(b) DFB 腔。

- 温度对纵模谱的影响由于有源层材料的禁带宽度  $E_g$  随温度增加而变窄，使激光波长发生红移，其红移量约为  $0.2 \sim 0.3 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。该值与器件的结构和有源区材料有关。借此特性，可以用适当的温度控制来微调激光的峰值激光波长，以满足对波长要求严格的一些应用。和稳定输出功率一样，如需要有稳定的工作波长，对半导体激光器需进行恒温控制。

### 三 实验内容及步骤

本实验要求正确搭建光路，测量出未整形的半导体激光器远场模式（横模与侧模）分布，并用坐标纸作图。同时测量不同激励电流下半导体激光器的纵模谱分布特性。

#### 3.1 横模和侧模分布测量

- 将 635nm 半导体激光器控制电缆连接至 LD1 控制器。

2. 将Si-PD固定于三维调整架，信号输出连接至PD1.IN。设置PD1量程（RTO）为1mW档。
3. 设置LD1工作模式（MOD）为恒流模式（ACC），调节LD1驱动电流（ $I_c$ ）至30.0mA。
4. 调节Si-PD左右位置，使其受光表面距635nm半导体激光器发光面约20mm。
5. 调节Si-PD位置，使PD1输出信号最大，记录此时的位置。
6. 以此位置为中心，沿横轴在中心点 $\pm 5$ mm范围内每隔0.5mm测一个点，作激光器空间横模分布曲线。
7. 沿侧向轴在中心点 $\pm 5$ mm范围内每隔0.5mm测一个点，作激光器空间侧模分布曲线。

### 3.2 纵模测量

1. 将1550nm FP-LD控制信号连接至LD1.OUT，设置LD1工作模式（MOD）为恒流模式（ACC），驱动电流（ $I_c$ ）置为0。
2. 将1550nm FP-LD光信号连接至光谱分析器，输入狭缝置2mm，输出狭缝置0.1mm。
3. 调节1550nm FP-LD驱动电流（ $I_c$ ），从10 ~ 40mA每隔5mA测一次1550nm FP-LD输出光谱，波长范围1500 ~ 1600nm，波长间隔0.1nm。读取不同驱动电流下的峰值波长、线宽和边模抑制比。

## 四 思考题

实验完成后，请思考并回答如下的问题：

1. 半导体激光器的模式具有什么样的特性？分布就横模、侧模、和纵模三方面说明。
2. 比较整形圆化前后的635nm半导体激光器的输出模式，分析通过哪些方法可得到较好的高斯形状的光束？